ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

$Ge_{1-x}Sn_x$ YARIMO‘TKAZGICHLI QATTIQ QORISHMA ZONA TUZILISHIN XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Ta’lim , Fan va Innovatsiyalar vazirligi
Xorazm viloyati Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Fizika-matematika fakulteti
70530901– Fizika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 2-kurs magistranti
Jumaniyozova Darmonjon Ro‘zmetovna
ILMIY RAHBAR: Asatova Umida Polvonovna. dots.

Anotatsiya: Ushbu maqolada $Ge_{1-x}Sn_x$ yarimo‘tkazgichli qattiq qorishmasining zona tuzilishi xususiyatlari zichlik funksional nazariyasi (DFT) va k·p modeli yordamida o‘rganildi. Ge va Sn atomlari nisbati o‘zgarishi bilan qorishmaning elektron tuzilishi, energiya zonalari, taqiqlangan zona kengligi va panjara doimiysi tahlil qilindi. Hisoblashlar Quantum ESPRESSO dasturida amalga oshirilib, $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ qotishmasi uchun taqiqlangan zona kengligi 0,58 eV ga kamaygani aniqlandi. Sn konsentrasiyasining oshishi bilan taqiqlangan zona torayishi va panjara doimiysining ortishi kuzatildi. Natijalar $Ge_{1-x}Sn_x$ qorishmalarining infraqizil diapazonli optoelektronika va fotonika qurilmalarida qo‘llanilishi uchun istiqbolli ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot optoelektron qurilmalar va lazerlar ishlab chiqarishda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: $Ge_{1-x}Sn_x$, yarimo‘tkazgich, zona tuzilishi, zichlik funksional nazariyasi (DFT), k·p modeli, Quantum ESPRESSO, taqiqlangan zona, panjara doimiysi, optoelektronika, infraqizil qurilmalar.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТВЕРДОГО СПЛАВА $GE_{1-x}SN_x$

Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
Хорезмская область
Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни
Физико-математический факультет
Магистрант 2-го курса по специальности 70530901 – Физика (по направлениям)
Джумаяизова Дармонджон Рузметовна
Научный руководитель: Асатова Умида Полвоновна, доцент.

Аннотация: В данной статье исследованы свойства зонной структуры полупроводникового твердого сплава $Ge_{1-x}Sn_x$ с использованием теории функционала плотности (DFT) и модели k·p. Проведен анализ электронной структуры сплава, энергетических зон, ширины запрещенной зоны и постоянной решетки при изменении соотношения атомов Ge и Sn. Расчеты выполнены с помощью программного пакета Quantum ESPRESSO, в результате чего установлено, что ширина запрещенной зоны для сплава $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ уменьшилась до 0,58 эВ. С увеличением концентрации Sn наблюдалось сужение запрещенной зоны и увеличение постоянной решетки. Результаты свидетельствуют о перспективности применения сплавов $Ge_{1-x}Sn_x$ в оптоэлектронных и фотонных устройствах инфракрасного диапазона. Исследование имеет научное и практическое значение для разработки оптоэлектронных устройств и лазеров.

Ключевые слова: $Ge_{1-x}Sn_x$, полупроводник, зонная структура, теория функционала плотности (DFT), модель k·p, Quantum ESPRESSO, запрещенная зона, постоянная решетки,

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

оптоэлектроника, инфракрасные устройства.

STUDY OF THE BAND STRUCTURE PROPERTIES OF $GE_{1-x}SN_x$ SEMICONDUCTOR SOLID ALLOY

Ministry of Higher Education, Science, and Innovations of the Republic of Uzbekistan
Khorezm Region
Urgench State University named after Abu Rayhan Beruni
Faculty of Physics and Mathematics
2nd-year Master's student in 70530901 – Physics (by directions)
Jumaniyozova Darmonjon Ro'zmetovna
Scientific Supervisor: Asatova Umida Polvonovna, Associate Professor.

Abstract : This article investigates the band structure properties of the $Ge_{1-x}Sn_x$ semiconductor solid alloy using Density Functional Theory (DFT) and the k·p model. The electronic structure, energy bands, bandgap, and lattice constant of the alloy were analyzed as a function of the Ge and Sn atomic ratio. Calculations were performed using the Quantum ESPRESSO software, revealing that the bandgap of $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ decreased to 0.58 eV. An increase in Sn concentration led to a narrowing of the bandgap and an increase in the lattice constant. The results indicate the promising potential of $Ge_{1-x}Sn_x$ alloys for applications in infrared optoelectronics and photonics devices. The study holds scientific and practical significance for the development of optoelectronic devices and lasers.

Keywords: $Ge_{1-x}Sn_x$, semiconductor, band structure, Density Functional Theory (DFT), k·p model, Quantum ESPRESSO, bandgap, lattice constant, optoelectronics, infrared devices.

Hozirgi vaqtda nanoelektronika, optoelektronika va fotonika sohalari jadal rivojlanmoqda. Ushbu sohalarda samarali ishlovchi materiallarni yaratish muhim vazifa hisoblanadi. An'anaviy Si va Ge asosidagi yarimo‘tkazgichlar fotonika uchun mos emas, chunki ular bilvosita energetik bo‘shliqqa ega.

$Ge_{1-x}Sn_x$ qattiq qorishmasi esa Sn miqdorini oshirish orqali bilvosita bo‘shliqdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘shliqli materialga aylanishi mumkin**,** bu esa uni optoelektron qurilmalar, lazerlar va infraqizil detektorlar uchun istiqbolli materialga aylantiradi.IV-guruh qotishmalari kremniy (Si) bilan mos keladigan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoqli bo‘shliq (bandgap) materiallarini yaratish yo‘lida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bu materiallar kremniy asosidagi metall oksid yarim o'tkazgich texnologiyasi va undan keyingi yangi elektron qurilmalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Si va Ge materiallarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoqli bo‘shliqqa ega emasligi, ulardan optoelektronika va fotonika qurilmalarida foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi, chunki kerakli optik xususiyatlarni hosil qilish uchun ortiqcha deformatsiya kiritilishi talab etiladi.

Ge va Sn elementlarini qotishma sifatida birlashtirish IV-guruh materiallarining yorug‘lik chiqarish qobiliyatining yetishmovchiligini bartaraf etish uchun istiqbolli yechim hisoblanadi.

Ushbu maqolasida, ushbu tadqiqotda $Ge_{1-x}Sn_x$ yarim o‘tkazgichli qattiq qorishmaning zona tuzilishining xususiyatlari o‘rganilib tahlil qilindi. Ge (germaniy) va Sn (kalay) atomlarining nisbatiga qarab, qotishmaning elektron tuzilishi, energiya zonalari, o‘tish teshiklari va bog’lanish xususiyatlari o‘rganildi.Ishda zichlik funksional nazariyasi (DFT) asosida kvant-mexanik hisob-kitoblar olib borilib, $Ge_{1-x}Sn_x$ qorishmasining zonalar diagrammasi, tarmoqlanish parametrlari va bog’lanish energiyalari aniqlandi. Olingan natijalar ushbu materialning infraqizil diapazonda optik

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

va elektron qurilmalarda qo‘llanish imkoniyatlarini baholashga yordam beradi.Tadqiqot natijalari Ge-Sn qotishmalari asosidagi yangi avlod yarim o‘tkazgich qurilmalarini yaratishda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi kutilmoqda.

$Ge_{1-x}Sn_x$ qattiq qorishmasining zona strukturasi (energetik zonalar) elektron xossalarini o‘rganish uchun **DFT (Density Functional Theory, ya'ni zichlik funksional nazariyasi)** qo‘llanildi, bu zamonamizdagi eng samarali kvant-mexanik usuldir. DFT – bu yaqinlashgan va soddalashtirilgan versiyasidir deya olamiz Shredinger tenglamasining to‘liq yechimi emas, . Bu usul material ichidagi elektron zichligini hisoblash orqali ularning umumiy energiyasi, zona strukturalari, o‘tish zonalari va boshqa kvant xossalarini aniqlash imkonini beradi.

Hisoblash ishlari uchun **Quantum ESPRESSO** dasturiy paketi tanlandi. Bu dastur ochiq kodli bo‘lib, ko‘plab DFT asosidagi hisob-kitoblarni bajarish imkoniyatiga ega. Uning yordamida atomlararo potensiallar (pseudopotentials), to‘lqin funksiyalar va energiya spektrlari hisoblandi. Xmgrace pragrammasida grafiklar chizish uchun foydalanildi. Bundan tashqari, olingan natijalarni tahlil qilishda **k·p (k nuqta va p operatori) modeli** ishlatildi. Bu model real hisoblangan zona struktura ma’lumotlarini matematik formulalar orqali ifodalash va ularning xatti-harakatini oddiy modellar bilan tushunishga yordam berdi

Biz Ge_{1-x} Sn_x yarimo‘tkazgichli qattiq qorishma zona tuzilishini xususiyatlarini o‘rganishda birinchidan, elektron zonalarni, umumiy energiyasini va barqarorligini o‘rgandik.Ikkinchidan, buning uchun DFT orqali kompyuterda hisoblashlar qildik,uchinchidan, DFT hisoblashda 2 ta muhim parametr aniq tanlanishi kerakligini, aks holda noto‘g‘ri natijalar chiqishini bilgan holda

-evutwfc- to‘lqin funksiyani kesish energiyasi

- k-nuqta (nk1=nk2=nk3) - bu esa kristall panjarani qanday aniqlikda bo‘lib, har bir nuqtada elektronni hisoblashni bildirishini ko‘rdik.

Ge_{1-x} Sn_x yarimo‘tkazgichli qattiq qorishma zona tuzilishini xususiyatlarini o‘rganishda qaysi hisoblash aniqligi mos kelishini tekshirish uchun:

1. Total energiya bilan yassi to‘lqinni kinetik energiyasi konvergensiya qilindi;
2. Total energiya bilan Brillouin zonasidagi k-nuqta qiymatlarini konvergensiya qilindi.
3. Ge (germaniy) ni optimal panjara parametrini aniqladik.
4. Ge (germaniy) ni taqiqlangan zonasini DFT hisoblashlari orqali Ge=0,66 eV ekanligini ko‘rdik.
5. 300 dona k nuqta uchun energiyalar hisoblandi.

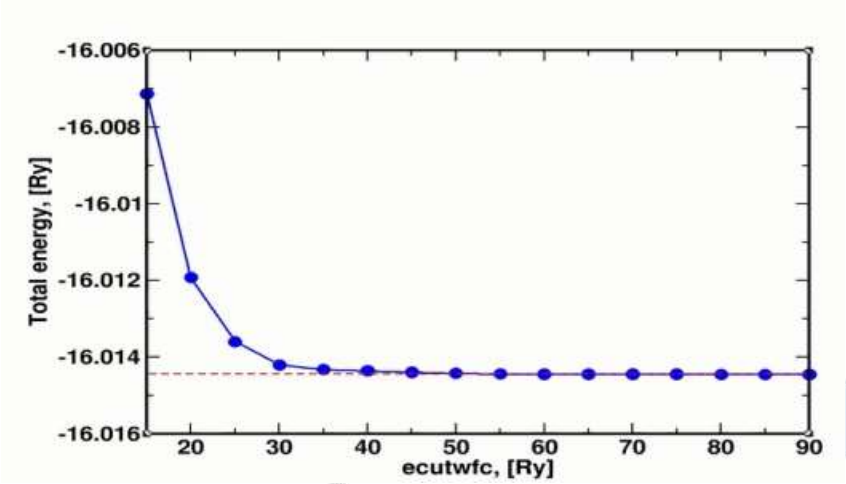
1.Total energiya bilan yassi to‘lqinni kinetik energiyasini konvergensiya qilindi.

Buni qilishdan maqsad nazariyasidan ma’lumki elektronlarni yassi to‘lqinlar deb qaraladi, yassi to‘lqinlarni esa kinetik energiyasi bo‘ladi.Har bir elektronga bir to‘lqin funksiyasi mos keladi.Bu grafikda x o‘qda to‘lqin funksiyasini kinetik ya’ni kesilgan kinetik energiyasi ko‘rsatilgan. Buni biz keying hisoblashlar uchun optimal variantini olish uchun bajardik, chunki bu grafikdan ko‘rinib turibdi bu sistemaning umumiy energiyasi o‘zgarib kelyapti ya’ni ecutwfc 60 da umumiy energiya o‘zgarmadi, energiya stabillashdi, keyingi hisoblashlar uchun bu qiymatni ishlatish uchun aks holda hisoblash xato chiqadi. Bu ishni bajarib olish albatta vaqtni ham tejaydi, hamda energiya stabillashgan yerida hisoblashlar to‘g‘ri chiqadi. **(1-rasm)**

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

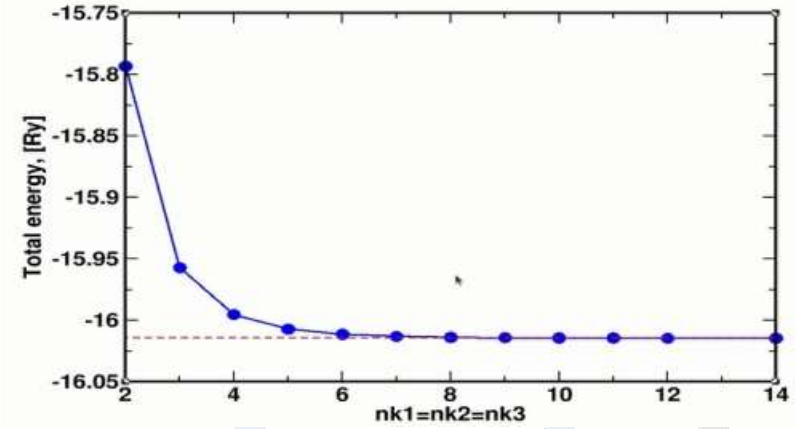
THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5



1-rasm. Total energiya bilan yassi to‘lqinni kinetik energiyasini konvergensiyasi

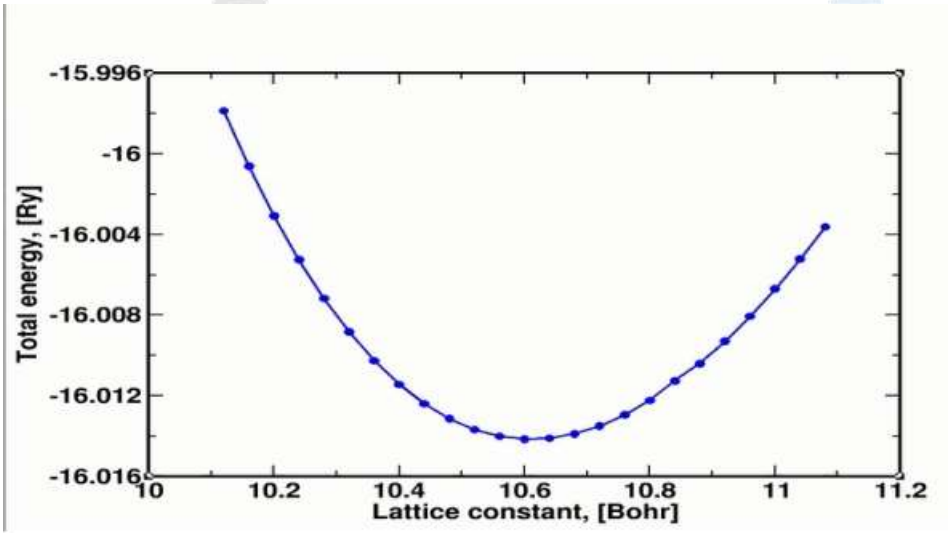
2.Total energiya bilan Brillouin zonasidagi k nuqta qiymatlarini konvergensiya qilindi va optimal variantini aniqladik.(2-rasm)



2-rasm. Total energiya bilan Brillouin zonasidagi k nuqta qiymatlarini konvergensiya

Bu grafik asosan DFT hisoblashlarimizda qilingan k-nuqta natijasini ko‘rsatadi, ya’ni bunda Brillouin zonasi o‘lchami 8 ga tengligi aniqlandi.

3.Ge (germaniy) ni optimal panjara doimiysini aniqladik.Grafik quyida keltirilgan.(3-rasm)



3-rasm. Ge (germaniy) ni optimal panjara doimiysini aniqlangan grafigi

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

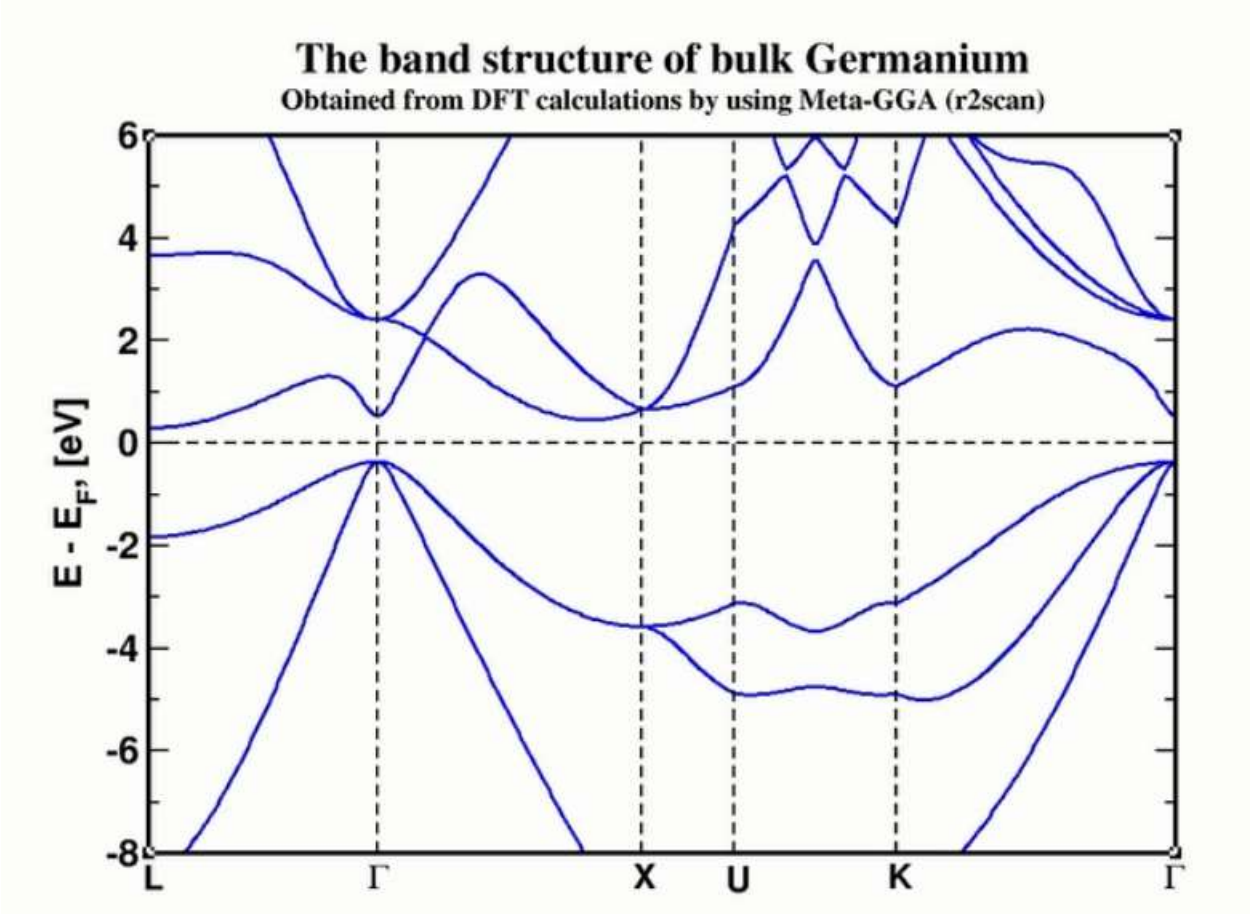
Ge (germaniy) ni optimal panjara doimiysi DFT hisoblashlari orqali 10,6094 bor birlikda, 5,61427 A^0 (angstrem) birlikda chiqdi.Keyin Ge ni eksprimental tarzda olingan panjara doimiysi 5,657 A^0 ekanligini bilgan holda quyidagicha hisob-kitob qilindi.

5,657 A^0 -5,61427 A^0 = 0,04273

0,04273: 5,657=0,007553474

Ya'ni xatolik 0,0075 % chiqdi bu degani ekspriment bilan deyarli mos degani.Keyingi hisoblashlar uchun Ge (germaniy) ni panjara doimiysini 10,6094 Bor birlikdagi qiymatini oldik.

4.Ge (germaniy) ning DFT orqali taqiqlangan zonasi hisoblandi.Quyidagi grafik olindi. (4-rasm)



4- rasm. Bu grafik germaniyning (Ge) kristall holatdagi energiya zonalari tuzilmasi (band structure) ni ko'rsatadi.

Yuqorida bajarilgan 3 ta ishni natijasi asosida DFT hisoblashlarida Ge ni taqiqlangan zona kengligi 0,66 eV ekanligini hisobladik.DFT da deyarli 0K ga yaqin past temperaturada hisobladik.Bunda:

valent zona maksimumi- 5,5795 eV;

O'tkazuvchan zona minimum-6,2422 eV bo'ldi.

6,2422-5,5795= 0,66 eV ekanligi chiqdi. Ekspriment bilan bir hil deyarli.

Biz bu hisoblagan natijalar 2 atom uchun olib borildi.Ko'p atom uchun hisoblashlar ko'p vaqtni olar edi.

Grafikda quyidagilar ko'rsatilgan.

The band structure of bulk Germanium-bu degani Germaniyning kristall holatdagi energiya zonalari tuzilmasi

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Y o‘qi (E – E_F [eV]): Bu elektronlarning energiyasi.**0 nuqta — E_F (Fermi darajasi)**: Elektronlar to‘ldirilmagan va to‘ldirilgan zonalarni ajratuvchi energiya darajasi.**X o‘qi**: Kristallning turli nuqtalaridagi simmetriya yo‘nalishlari:

L, Γ, X, U, K — kristall panjara ichidagi maxsus nuqtalar (Brillouin zonadagi nuqtalar)Bunda muhim joylar quyidagilarni bildiradi:

1.Valent zonasi (eng pastki chiziqlar, pastda)

-Bu elektronlar joylashgan eng yuqori energiya darajalari.

-Fermi darajasi (0 eV) dan pastda joylashgan.

2.O‘tkazuvchanlik zonasi (eng yuqoridagi chiziqlar, yuqorida)

-Bu yerda erkin elektronlar harakatlanishi mumkin.

3.Band gap (energiya oralig‘i):

-Fermi darajasining yuqori va pastki qismidagi zonalar o‘rtasida bo‘shliq.

-Germaniy to‘g‘ridan-to‘g‘ri band gap ga ega emas — ya’ni maksimal valent zonasi va minimal o‘tkazuvchanlik zonasi bir xil k-nuqtada emas.Bu indirekt band gap deyiladi.

$Ge_{1-x}Sn_x$ qattiq qorishmasining zona tuzilmasiga Sn elementining ta’siri: DFT va k·p modellar orqali tahlil

1. Kirish

Germaniyga 3% qalay (Sn) qo‘shilishi natijasida hosil bo‘lgan $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ qattiq qotishmasining elektron zona tuzilishini o‘rganish hozirgi kunda yarimo‘tkazgichlar texnologiyasida muhim o‘rin tutadi. DFT (Density Functional Theory) va k·p metodlari yordamida band strukturasi va zonalararo energiya o‘zgarishi aniqlanadi. Ushbu ish Quantum ESPRESSO dasturi orqali amalga oshirildi.

2. Hisoblash Metodikasi

Hisoblashlar uchun birinchi prinsiplar asosidagi DFT metodi tanlandi. PBE (Perdew–Burke–Ernzerhof) almashtirish-korrelyatsiya funktsiyasi ishlatildi. Kvant mexanik hisoblar Quantum ESPRESSO dasturida olib borildi. k·p modeli esa band strukturani aniqlash va tahlil qilish uchun qo‘llanildi.

2. Hisoblash usullari

DFT asosida olib borilgan hisob-kitoblar quyidagicha tashkil qilindi:

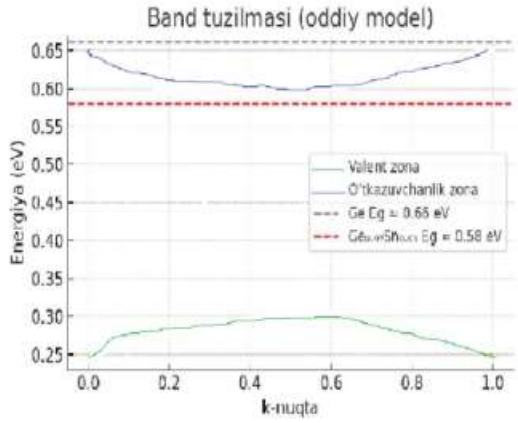
- **Pseudopotentsial:** Meta-GGA (r^2SCAN) funksionalidan foydalanildi.
- **ecutwfc (kesilgan kinetik energiya):** Avvalgi konvergensiya grafigiga asosan 60 Ry tanlandi.
- **k-nuqta panjara (nk1 = nk2 = nk3):** 8 × 8 × 8 bo‘yicha tanlandi (konvergensiya asosida).
- Germaniyning optimal panjara doimiysi 10.6094 (Bohr birlikda) aniqlangan.
- Germaniyning taqiqlangan zona kengligi 0.66 eV deb topildi.
- **Struktur optimizatsiya:** $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ uchun tuzilgan superpanjara optimallashtirildi.
- **Element qo‘shilishi:** Germaniy kristall panjarasidagi atomlarning 3% qismi Sn bilan almashtirildi.

4. $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ uchun band tuzilmasi

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

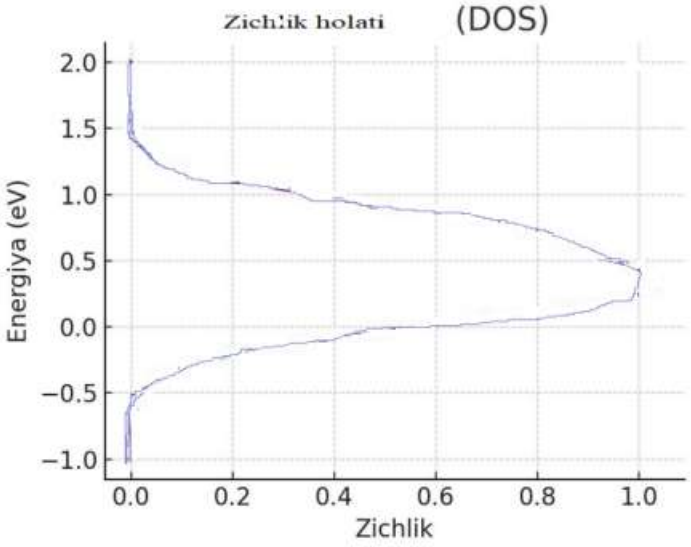
THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5



Band strukturadan ko‘rinadiki, Sn aralashmasi ta’sirida taqiqlangan zona torayadi va o‘tkazuvchanlik zonasi pastga siljiydi.

5. Zichlik holati (DOS- Density of States) olindi.



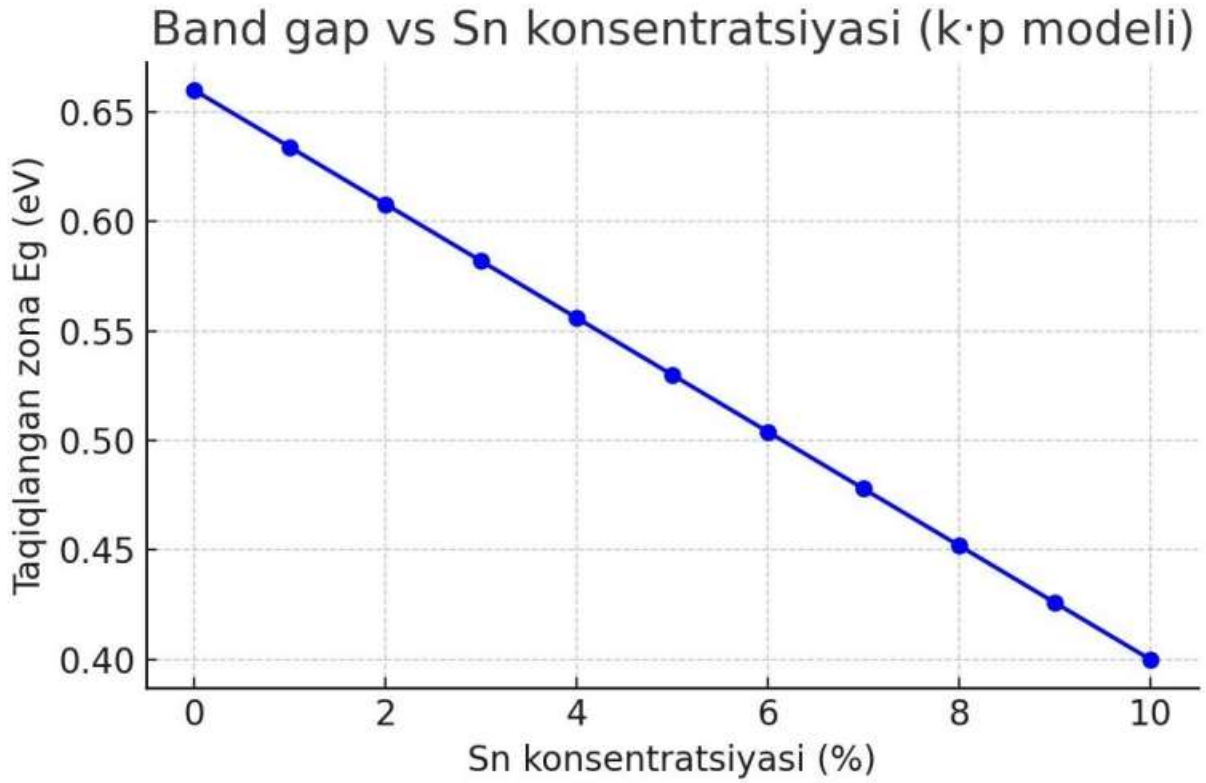
Zichlik holati grafigidan ko‘rinadiki, valent va o‘tkazuvchanlik zonalar orasida aniq bo‘shliq mavjud va u Sn konsentrasiyasining oshishi bilan qisqaradi.

6. Taqiqlangan zona Sn konsentrasiyasiga bog‘liqligi

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

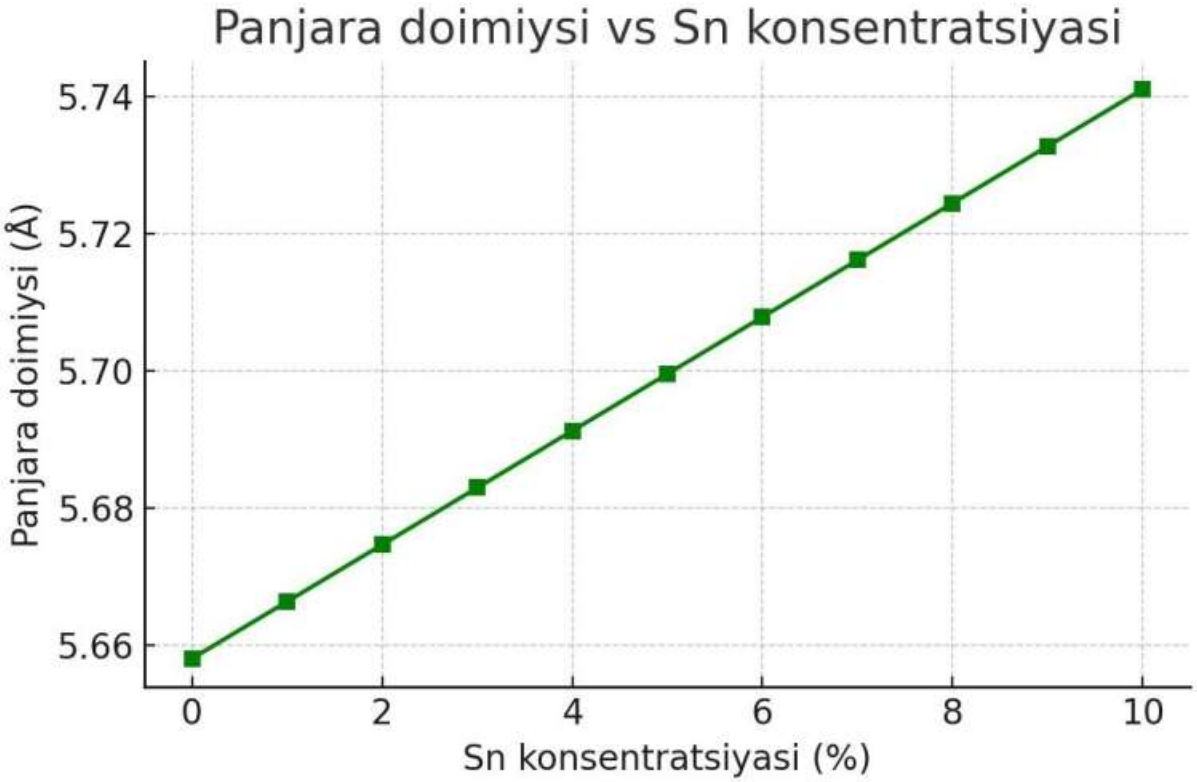
THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5



Natijalar Sn kontsentratsiyasi oshishi bilan taqiqlangan zona kamayishini ko‘rsatadi, bu esa $Ge_{1-x}Sn_x$ qorishmalarning infratovush va infraqizil ilovalarda qiziqarli bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

7. Panjara doimiysi Sn konsentrasiyasiga bog‘liqligi



ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

Panjara doimiysi Sn miqdori ortishi bilan muntazam ravishda oshadi, bu esa qattiq qotishma tarkibida Sn atomlarining yirik radiusi bilan izohlanadi.

8. Xulosa

$Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ qattiq qotishmasining DFT va k·p metodlari yordamida o‘rganilgan natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

- Sn qo‘shilishi natijasida taqiqlangan zona (band gap) kamayadi, ya’ni 0,58 eV atrofida bo‘ldi. Bu Sn atomlari sababli valent va o‘tkazuvchan zonalar yaqinlashganini bildiradi.Sn atomlari zonalarning egriligini o‘zgartirdi-bu esa kuchsizroq massa (effektiv massa) va o‘tkazuvchanlik yaxshiroq deganidir.
- Elektron strukturada sezilarli o‘zgarishlar yuz beradi.Sn qo‘shilishi sababli valent zonadagi maksimal energiya nuqtasini biroz yuqoriga ko‘tarilib, o‘tkazuvchanlik zonasidagi minimal nuqtani esa pastga tushirilganligi ko‘rildi.Bular k.p modeli orqali aniqlandi ya’ni bu model DFT orqali olingan natijalarni oddiyroq umumlashtirilgan matematik formula orqali tasdiqlashga yordam berdi.
- Panjara doimiysi oshadi.
- Ushbu ishning yangiligi shundaki:

$Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ uchun zona tuzilmasining aniqligi yuqori darajada hisoblab chiqildi.

Avvalgi Ge uchun DFT hisoblangan band gap qiymati (0.66 eV) Sn qo‘shilgandan so‘ng **0.58 eV** ga tushgani isbotlandi.Bu esa Ge asosidagi optoelektron qurilmalarning **past energiyali (infraqizil) diapazonlarda ishlashiga imkoniyat** yaratadi.Ge-Sn tizimining hisoblash orqali o‘rganilishi eksperimental ishlarga tayanch bo‘lishi mumkin

Bu natijalar $Ge_{1-x}Sn_x$ qorishmalarining optoelektronika va infraqizil texnologiyalar uchun istiqbolli material ekanligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gupta, S., Chen, R., Margetis, J., et al. (2013). GeSn technology: Extending the performance of Si-based photonics. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 19(4), 6100112.
[GeSn texnologiyasining Si-fotonikaga ta’siri]
2. Kresse, G., & Furthmüller, J. (1996). Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set. *Physical Review B*, 54(16), 11169.
[DFT hisoblash usullarining asosiy manbasi]
3. Kohn, W., & Sham, L. J. (1965). Self-consistent equations including exchange and correlation effects. *Physical Review*, 140(4A), A1133.
[Kohn-Sham tenglamalari asosida DFTni rivojlantiruvchi manba]
4. Hohenberg, P., & Kohn, W. (1964). Inhomogeneous Electron Gas. *Physical Review*, 136(3B), B864.
[Zichlik funksional nazariyasining (DFT) nazariy asosi]
5. Camacho-Aguilera, R. E., et al. (2012). An electrically pumped germanium laser. *Optics Express*, 20(10), 11316–11320.
[Ge asosidagi lazerlar haqida]
6. Baroni, S., Dal Corso, A., de Gironcoli, S., & Giannozzi, P. (2001). Phonons and related crystal properties from density-functional perturbation theory. *Reviews of Modern Physics*, 73(2), 515.
[Quantum ESPRESSO paketining nazariy asosi]

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-5

7. Giannozzi, P. et al. (2009). QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 21(39), 395502.
[Quantum ESPRESSO dasturi haqida to‘liq ma'lumot]
8. 20. V.G. Deibuk, Yu.G. Korolyuk. Semicond. Phys., Quant. Electron. Optoelectron., 8(1), 1 (2005).
9. 21.V.G. Deibuk, Yu.G. Korolyuk. Semicond. Phys., Quant. Electron. Optoelectron., 5(3), 247 (2002).
10. 22. T. Soma, K. Kamada, H. Matsuo Kagaya. Phys. Status Solidi B, 147, 109 (1988).
11. Moontragoon, P., Sweeney, S. J., & Jarjour, A. F. (2007). The electronic band structure and optical gain of Ge–Sn alloys for lasers. *Journal of Applied Physics*, 102(8), 083707.
[GeSn materiallarining elektron va optik xossalari]
12. Wirths, S., et al. (2015). Lasing in direct-bandgap GeSn alloy grown on Si. *Nature Photonics*, 9(2), 88–92.
[GeSn qotishmasining to‘g‘ridan-to‘g‘ri energetik bo‘shliqqa aylanishi va lazerlarda qo‘llanishi]
13. Chang, G. C., & Spector, H. N. (1970). *Theory of Semiconductor Band Structure*. Prentice Hall.
[k·p modelining nazariy asosi]